

ВЛИЯНИЕ АНГАРМОНИЧНОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ИНКРЕМЕНТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ЛСЭ ТИПА СТРОФОТРОНА

В. Г. Барышевский, А. В. Зеге, В. В. Тихомиров

1. Релятивистский строфотрон (РС) — один из типов лазера на свободных электронах (ЛСЭ), в котором для обеспечения поперечных осцилляций электронов используется продольно-однородное и поперечно-неоднородное статическое поле (вместо магнитного ондулятора в традиционном ЛСЭ), впервые был рассмотрен в работе [1] (в предположении о гармоничности поперечного потенциала). В тесной связи со строфотроном находятся ЛСЭ, использующие естественные поля с той же симметрией, что и поле строфотрона [2, 3]. Однако в этом случае ангармоничность полей весьма высока [3]. Заметим, что и в обычном РС, основанном на использовании квадрупольных линз [4], учет ангармоничности потенциала (АП) также необходим при рассмотрении больших токов (поскольку большой ток связан с большим поперечным размером пучка, а в этом случае приближение гармонического потенциала, применимое вблизи оси, неизбежно становится несправедливым). Данная работа посвящена анализу влияния АП на группировку и неустойчивость в строфотроне. Показано, что в АП появляется новый механизм неустойчивости (помимо известных для гармонического РС механизмов). Приведены критерии, позволяющие определить, какой из механизмов неустойчивости преобладает (при произвольной форме потенциала) и при каких параметрах можно пренебречь ангармонизмом.

2. Рассмотрим пучок ультрарелятивистских электронов, движущихся в поперечном одномерном электростатическом поле. Направим ось z вдоль направления поступательного движения электронов, а ось x — вдоль градиента потенциала $U(x)$. Тогда скорость v электрона запишется в виде $v = v_x e_x + v_z e_z$ (e_x, e_z — координатные орты). Полная энергия электрона $E = m\gamma + U(x)$ (γ — лоренц-фактор частицы, $c=1$). Поскольку $U(x) \ll E$, то энергия (с точностью до U^2/E) $E \approx E_{||} + \epsilon$, где $E_{||} = \sqrt{p_{||}^2 + m^2}$, $p_{||} = mv_z \gamma$, а $\epsilon = E_{||} v_x^2 / 2 + U(x)$ — энергия поперечного движения. Так как поперечная координата является периодической функцией времени, то ее можно представить в виде $x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{in(\Omega t + \varphi_0)}$, где x_n — амплитуда n -й гармоники, φ_0 — начальная фаза колебаний, $\Omega = \Omega(\epsilon, E_{||})$ — их частота (зависящая от продольной и поперечной энергии). При выполнении условия синхронизма $\omega - k_z v_z \approx n\Omega$ усреднение по быстрым осцилляциям позволяет получить уравнения, описывающие «медленное» изменение величин $E_{||}$, ϵ , v_x , θ ($\theta = \omega t - k_z z(t) - n \int \Omega(t) dt$), которые можно привести к универсальному виду уравнений ЛСЭ (см., например, [1])

$$\frac{d\eta_j}{dZ} = v_{x_n}(\epsilon_j) \operatorname{Re}(ae^{i\theta_j}), \quad \frac{d\theta_j}{dZ} = \delta(\epsilon_j) + \mu(\epsilon_j) \eta_j, \quad (1)$$

$$\frac{da}{dZ} = \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \langle v_{x-n} e^{-i\theta} \rangle, \quad (2)$$

где $a = eE_x / \omega E_{||0}$, $Z = \omega z$, $\eta_j = 1 - E_{||j} / E_{||0}$, $\omega_p^2 = 4\pi n e^2 / m\gamma$, n — концентрация электронов, E_x — x -компонента напряженности электромагнитного поля, а остальные «электронные» переменные имеют нетривиальную зависимость от поперечной энергии

$$\delta(\epsilon_j) = \frac{\omega - k_z v_z - n\Omega(\epsilon_j)}{\omega}, \quad \mu(\epsilon_j) = \left(\frac{3}{4\gamma^2} - \frac{n\Omega(\epsilon_j)}{2\omega} + \frac{m}{2\omega\gamma} \frac{\partial n\Omega}{\partial \epsilon_j} \right). \quad (3)$$

Угловые скобки в (2) обозначают усреднение по электронам $\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j$, где j — номер электрона.

Формула (3), во-первых, обобщает соответствующую формулу из [1] на случай АП. Во-вторых, она уточняет формулу для параметра неизохронности в гармоническом потенциале. В ней учтено несодержащееся в [1] слагаемое, связанное с зависимостью продольной ско-

рости от поперечной энергии, которое и в гармоническом строфотроне является величиной одного порядка с учтенными в [1]. Анализируя стандартным методом устойчивость системы уравнений (1), (2), приходим к дисперсному уравнению

$$\Gamma = \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \int_0^{\varepsilon_{\max}} d\varepsilon f(\varepsilon) \frac{|v_{xn}(\varepsilon)|^2 \mu(\varepsilon)}{(\Gamma + \delta(\varepsilon))^2}, \quad (4)$$

мнимая часть корня которого дает инкремент роста неустойчивого решения ($f(\varepsilon)$ — начальная функция распределения по поперечным энергиям, ε_{\max} — высота потенциального барьера). Основные черты неустойчивости, описываемой уравнением (4) в обсуждаемых (см. [2-3]) ЛСЭ, можно аналитически исследовать для ступенчатой функции распределения

$$f(\varepsilon) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta\varepsilon}, & |\varepsilon - \varepsilon_0| < \Delta\varepsilon, \\ 0, & |\varepsilon - \varepsilon_0| > \Delta\varepsilon. \end{cases}$$

В этом случае (4) сводится к алгебраическому уравнению

$$\Gamma^3 + 2\delta(\varepsilon_0)\Gamma^2 + \left(\delta^2(\varepsilon_0) - \left(\frac{\partial\Omega}{\partial\varepsilon} \frac{\Delta\varepsilon}{\omega}\right)^2\right)\Gamma - \rho^3 = 0, \quad (5)$$

где $\rho = (\omega_p^2/2\omega^2 |v_{xn}(\varepsilon_0)|^2 \mu(\varepsilon_0))^{1/3}$.

Исследование уравнения (5) показывает, что инкремент неустойчивости близок к своему максимальному значению $\Gamma^0 = \sqrt{3}/2\omega\rho$, если

$$\frac{\partial\Omega}{\partial\varepsilon} \Delta\varepsilon \leq \omega\rho. \quad (6)$$

Условие (6) позволяет определить (в случае АП) интервал поперечных энергий, содержащий электроны, резонансно взаимодействующие с волной. С другой стороны, из (6) получаем оценку применимости в реальной ситуации теории гармонического строфотрона $\partial\Omega/\partial\varepsilon \ll \ll \omega\rho/\varepsilon_{\max}$. Для ЛСЭ, рассмотренных в [2, 3], $\partial\Omega/\partial\varepsilon \sim \Omega/\varepsilon_{\max}$, и нетрудно убедиться в том, что из членов, входящих в параметр неизохронности, наибольшую величину имеет тот, в который входит $\partial\Omega/\partial\varepsilon$. Действительно, сравнивая слагаемые, входящие в $\mu(\varepsilon)$, имеем $\partial\Omega/\partial\varepsilon m/\omega\gamma/1/\gamma^2 \sim m/\varepsilon_{\max}\gamma \gg 1$ (последнее неравенство использует дипольное приближение, равносильное условию $\varepsilon_{\max}\gamma/m \gg 1$). Таким образом, инкремент неустойчивости определяется в этом случае механизмом, связанным с ангармоничностью поперечного потенциала.

Литература

- [1] Братман В. Л., Гинзбург Н. С., Петелин М. И. // Изв. АН СССР. 1980. Т. 44. № 8. С. 1593—1602.
- [2] Высоцкий В. И., Кузьмин Р. Н. // ЖТФ. 1983. Т. 53. Вып. 7. С. 1254—1260.
- [3] Kurezki G., Strauss M., Oreg J., Rostoker N. // Phys. Rev. A. 1987. Vol. 35. N 8. P. 3424—3432.
- [4] Нерсисов Э. А., Оганесян К. Б., Федоров М. В. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 12. С. 2402—2404.

Научно-исследовательский институт ядерных проблем при Белорусском государственном университете им. В. И. Ленина
Минск

Поступило в Редакцию
29 июля 1987 г.
В окончательной редакции
16 мая 1988 г.